## УДК 535.34.549.517.1

## РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В NI-РУБИНЕ

Т. С. Бессонова, А. И. Собко, М. П. Станиславский (НИИЯФ)

В ранее опубликованных нами работах (см., например, [1]) сообщалось о том, что по своему влиянию на раднационно-оптические эффекты в легированном рубине (т.е. кристаллах  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+Cr+Me, где Me—Mg, Ti, Mn, Co, Ni) дополнительные примеси (Me) можно разбить на три группы, к одной из которых относятся Со и Ni. В настоящей статье излагаются подробные сведения о влиянии никеля на наведенное ионизирующей радиацией поглощение (HП), радио- и термостимулированную люминесценцию (РЛ и ТЛ) рубина и выясняется физическая сущность обнаруженных явлений.

Объектами для исследований служили образцы рубина, выращенные методом Вернейля и подвергнутые высокотемпературной обработке в вакууме или кислороде. Концентрация трехвалентного хрома во всех



Рис. 1. Спектры наведенного поглощения образцов Ni-рубина, термообработанных в вакууме. Содержание никеля в вес. %: 0,3 (1); 0,1 (2); 1 (3); 0,03 (4) и 0,01 (5)

образцах была одной и той же (~0,02 вес.%). Было изучено 6 групп кристаллов Ni-рубина с номинальной концентрацией никеля от 0,01 до 2 вес.%. Каждая группа содержала 4 образца (два — толщиной 5 мм и два — толщиной 1 мм).

При изучении НП и ТЛ образцы облучались до насыщения окраски у-излучением <sup>60</sup>Со (доза 10<sup>6</sup>P), РЛ измерялась при возбуждении электронами радиоактивного источника <sup>204</sup>Tl





(мощность дозы  $\sim 3$  рад·с<sup>-1</sup>). Облучение во всех случаях производилось при комнатной температуре.

Как известно, спектр НП чистого рубина состоит из четырех полос [2]; он обусловлен захватом вторичных зарядов на дырочные ловушки,

образованные хромом [3]. Этот спектр в дальнейшем будем обозначать как  $H\Pi_{Cr}$ . Пик термолюминесценции, возникающий при разрушении наведенных центров окраски (~580 K), обозначим через  $T\Pi_{Cr}$ , а радиолюминесценцию хрома, возбуждаемую в процессе облучения, назовем  $P\Pi_{Cr}$ .

Спектры НП «вакуумных» и «кислородных» образцов Ni-рубина содержат полосы, обусловленные как хромом, так и никелем. Соответствующие кривые для кристаллов, термообработанных в вакууме, приведены на рис. 1. Как в «вакуумных», так и в «кислородных» образцах изменение интенсивности НП<sub>сг</sub> за счет изменения зарядовых состояний



Рис. 3. Кривая термолюминесценции для образца Ni-рубина, содержащего 0,3 вес. % никеля и термообработанного в вакууме (сплошные кривые) и кислороде (пунктир)



Рис. 4. Зонная схема Ni-рубина

ионов никеля приблизительно согласуется с интенсивностью НП в Ni-корунде при соответствующих концентрациях примеси. Другими словами, концентрация центров наведенной окраски, обусловленных хромом, практически не зависит от содержания никеля в Ni-рубине.

Кривые разгорания РЛ Ni-рубина имеют плавно нарастающий вид (рис. 2), причем по мере увеличения содержания Ni( $C_{Ni}$ ) интенсивность начальной и конечной РЛ убывает. В вакуумном Ni-рубине проявляется тенденция к увеличению степени разгорания РЛ с ростом  $C_{Ni}$ . Спектр РЛ Ni-рубина идентичен спектру РЛ чистого рубина.

На кривых ТЛ Ni-рубина кроме основного пика ~580 K, связанного с хромом, обнаруживаются дополнительные слабые пики: ~730 K в «вакуумных» образцах и 690 K в «кислородных» (рис. 3). Все характеристики пика  $TЛ_{Cr}$ , кроме интенсивности этого пика ( $I_m$ ) в «кислородных» образцах, практически не зависят от наличия никеля. Величина  $I_m$  в образцах, термообработанных в кислороде, незначительно падает при увеличении  $C_{Ni}$  без изменения типа кинетики ТЛ.

Таким образом, никель не влияет на интенсивность  $H\Pi_{Cr}$  в рубине ни после вакуумной, ни после кислородной термообработки. Остается неизменной кинетика (а в «вакуумных» образцах и интенсивность)  $T\Pi_{Cr}$ . Различные валентные состояния никеля привносят лишь аддитивную добавку к спектрам поглощения рубина до и после облучения. Следовательно, система электронно-дырочных ловушек в Ni-рубине, обусловленных никелем, при облучении до насыщения является замкнутой относительно системы электронно-дырочных ловушек, обусловленных хромом.

Физическую сущность обнаруженных явлений можно выяснить в рамках зонной модели твердого тела, применявшейся нами ранее для интерпретации радиационно-оптических эффектов в нелегированном рубине [4, 5]. В работе [4] изложены основные предпосылки соответствующей модели применительно к нелегированному рубину, приведена его зонная схема и указан смысл используемых в настоящей статье терминов и обозначений.

Согласно [6], зонная схема Ni-рубина (рис. 4) по сравнению с зонной схемой рубина должна содержать в общем случае четыре дополнительных уровня, принадлежащих Ni<sup>2+</sup> ( $v_2$ ), компенсатору заряда двухвалентного никеля ( $v_3$ ), Ni<sup>3+</sup> ( $v_4$ ) и некоторому дефекту ( $v_5$ ), формально идентифицированному как «дефектный никель» [6] (ему соответствует ряд полос НП, наиболее четкая из которых ~28 700 см<sup>-1</sup>).

Поскольку на уровне  $v_4$ , обусловленном Ni<sup>3+</sup>, локализация свободных зарядов не происходит [6], то в дальнейшем он из рассмотрения исключается. Приведенная зонная схема не учитывает некоторых процессов (например, делокализации захваченных зарядов ионизирующим излучением), вкладом которых на основании результатов работ [4, 5] можно пренебречь. Уровень  $v_5$  мы условно считаем дырочным, однако физическая сущность полученных дальше выводов не изменится, если этот уровень окажется электронным.

В процессе облучения ионизирующей радиацией Ni-рубина происходит заполнение как системы ловушек (v, v<sub>1</sub>), обусловленных хромом, так и системы ловушек (v<sub>2</sub>, v<sub>3</sub>, v<sub>5</sub>), обусловленных никелем.

Согласно [6], двухвалентный никель при облучении ионизирующей радиацией является дырочным центром захвата. Следовательно, полосы НП в Ni-рубине, принадлежащие никелю, обусловлены дырками, локализованными на уровнях v2, и зарядами, локализованными на уровне v<sub>3</sub> (в рассматриваемой схеме это также дырки). Очевидно, что степень заполнения ловушек (v2, v5) в стационарном состоянии не зависит от параметров системы ловушек (v, v<sub>1</sub>) только в том случае. когда ловушки  $v_2$  и  $v_5$  заполняются полностью, т. е.  $n_2 = v_2$ ,  $n_5 = v_5$ . Такая ситуация, по-видимому, имеет место. Действительно, вероятность тепловой делокализации дырок, захваченных ловушками  $v_2$  и  $v_5$ , пренебрежимо мала ввиду значительной глубины последних. С другой стороны, поскольку время выхода РЛ<sub>сг</sub> на насыщение в рубине и Ni-рубине примерно одно и то же, можно сделать вывод, что сечения рекомбинации β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>, β<sub>5</sub> пренебрежимо малы по сравнению с β.

С учетом сказанного уравнения баланса свободных и локализованных электронов в рамках рассматриваемой модели примут вид (для стационарного случая)

$$\sigma (v - n) u^{+} N^{+} - \beta n u^{-} N^{-} = 0,$$
  

$$\sigma_{1} (v_{1} - n_{1}) u^{-} N^{-} - \omega_{1} n_{1} = 0,$$
  

$$\sigma_{3} (v_{3} - n_{3}) u^{-} N^{-} - \omega_{3} n_{3} = 0,$$
  

$$\sigma (v - n) u^{+} N^{+} - \alpha_{0} = 0,$$
  

$$v_{2} + v_{5} + n = n_{1} + n_{3}.$$
  
(1)

Из системы уравнений (1) получим уравнение для концентрации заполненных дырочных ловушек n, обусловленных наличием хрома в решетке Ni-рубина (согласно [4], интенсивность  $H\Pi_{Cr}$  пропорциональна n):

$$\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_5 + n = \frac{\sigma_1 \mathbf{v}_1 \alpha_0}{\beta n \omega_1 + \sigma_1 \alpha_0} + \frac{\sigma_3 \mathbf{v}_3 \alpha_0}{\beta n \omega_3 + \sigma_3 \alpha_0}.$$
 (2)

Так как сечение рекомбинации  $\beta$  и сечение захвата  $\sigma_3$  характеризуют взаимодействие свободного заряда с притягивающим центром, можно утверждать, что  $\sigma_3$  одного порядка с  $\beta$ . А поскольку при возбуждении ионизирующей радиацией поглощение энергии происходит преимущественно в основном веществе, то будет выполняться соотношение

$$\sigma_3 \alpha_0 \gg \beta n \omega_3$$
.

(3)

Физический смысл неравенства (3) заключается в пренебрежении высвечивающим действием ионизирующей радиации, в результате чего ловушки  $v_3$  оказываются почти полностью заполненными, т. е.  $n_3 = v_3$ . Из выражения (2) вытекает, что система ловушек «замкнута», если

$$v_3 = v_2 + v_5$$
,

т. е. при легировании рубина никелем создаются электронные и дырочные ловушки в равном количестве. Такой вывод имеет важное значение, так как сужает круг возможных способов компенсации заряда двухвалентного никеля в решетке Ni-корунда.

Что касается снижения стационарной РЛ по мере роста содержания никеля в решетке (см. рис. 2), то основной причиной, по-видимому, является реабсорбция свечения на никелевых центрах поглощения. Однако, поскольку в высококонцентрированных «кислородных» образцах, которые в области излучения хрома являются более прозрачными, чем «вакуумные», снижается и интенсивность ТЛ<sub>Cr</sub> (без изменения ее кинетики), то можно предположить существование в «кислородных» образцах при высоких температурах какого-то механизма тушения. Природа такого тушения в настоящий момент пока не ясна.

Как следует из рис. 2, увеличение степени разгорания РЛ при увеличении количества никеля в образцах обусловлено резким уменьшением начальной интенсивности РЛ<sub>Сг</sub>. Этот факт объясняется тем, что на ранних стадиях облучения в связи с оттоком электронов и дырок на примесные никелевые ловушки количество зарядов, поступающих к хрому, ниже, чем в чистом рубине.

Таким образом, в результате настоящей работы получено, что система электронно-дырочных ловушек, обусловленных наличием никеля в рубине, в процессе стационарного облучения является замкнутой, т. е. не влияет на степень заполнения ловушек, принадлежащих хрому. Как следует из теоретического рассмотрения, такая ситуация возможна лишь в том случае, если существует определенная связь между концентрацией никеля в решетке корунда и количеством компенсирующих дефектов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Бессонова Т. С. и др. Журн. прикл. спектр., 1979, 30, № 5, с. 829. [2] Магиуата Т., Маtsuda Ү. J. Phys. Soc. Japan, 1964, 19, N 7, р. 1096. [3] Бессонова Т. С., Ганапольский Е. М., Хаимов-Мальков В. Я. Журн. прикл. спектр., 1981, 34, № 4, с. 690. [4] Бессонова Т. С., Собко А. И. Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон., 1979, 20, № 6, с. 62. [5] Бессонова Т. С., Собко А. И. Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон., 1979, 20, № 6, с. 62. [5] Бессонова Т. С., Собко А. И. Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон., 1980, 21, № 1, с. 63. [6] Бессонова Т. С., Станиславский М. П., Хаимов-Мальков В. Я. Опт. и спектр., 1975, 39, с. 697.

Поступила в редакцию 26.07.82